

JP2000200832 A

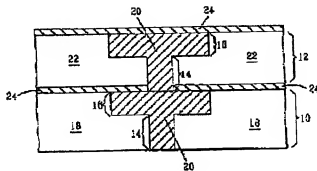
FORMATION OF COPPER INTERCONNECTION STRUCTURE
INTERNATL BUSINESS MACH CORP <IBM>

Inventor(s): PAUL D AGUNERO ; REENAP BUCKWALTER ; JOHN
HAMEL ; BARBARA LUTHER ; STAMPER ANTHONY K

Application No. 11363949 JP11363949 JP, **Filed** 19991222, **A1 Published**
20000718 **Published** 20000718

Abstract: PROBLEM TO BE SOLVED: To improve adhesiveness of a deposited inorganic barrier film to a copper surface of a copper interconnection structure by including exposure of a copper layer in an interconnected semiconductor structure to a reducing plasma before the formation of the inorganic barrier film on the copper interconnection structure.

SOLUTION: A copper interconnection structure is exposed to a reducing plasma before an inorganic barrier film 24 is deposited. This reducing plasma is a non-oxidizing, i.e., oxygen-atom-free plasma atmosphere. A suitable plasma is selected from H₂, N₂, NH₃, and rare gas, but it is not limited to these. Further, a combination of more than two of these reducing plasmas such as N₂ and H₂ is intended. N₂ and NH₃ are very preferable among these reducing plasmas. The adhesiveness of the inorganic barrier layer 24 to copper 20 can be improved by using this reducing plasma exposure process.



(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2000-200832

(P2000-200832A)

(43) 公開日 平成12年7月18日 (2000. 7. 18)

(51) Int.Cl.⁷

識別記号

F I

テマコード* (参考)

H 0 1 L 21/768

H 0 1 L 21/90

B

審査請求 有 請求項の数17 O L (全 6 頁)

(21) 出願番号 特願平11-363949
 (22) 出願日 平成11年12月22日 (1999. 12. 22)
 (31) 優先権主張番号 09/225530
 (32) 優先日 平成11年1月4日 (1999. 1. 4)
 (33) 優先権主張国 米国 (US)

(71) 出願人 390009531
 インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレーション
 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION
 アメリカ合衆国10504、ニューヨーク州
 アーモンク (番地なし)
 (74) 代理人 100086243
 弁理士 坂口 博 (外1名)

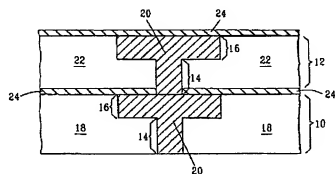
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 銅相互接続構造の形成方法

(57) 【要約】

【課題】 相互接続構造内に存在する銅表面に対する無機バリア膜の接着性を改良する方法を提供する。

【解決手段】 この発明は、デュアル・ダマシン構造のような半導体の相互接続構造内に存在する銅配線または銅パイアに対する付着無機バリア膜の接着性を増大するために、 H_2 、 N_2 、 NH_3 、および希ガス、並びにこれらの混合物から選択される還元プラズマ処理工程を用いる。



【特許請求の範囲】

【請求項 1】銅相互接続構造の形成方法において、

(a) 銅の層を有する相互接続構造を還元プラズマに暴露する工程と、

(b) 前記暴露された銅相互接続構造上に、無機バリア膜を形成する工程と、を含むことを特徴とする方法。

【請求項 2】前記暴露によって、前記銅相互接続構造上に形成された前記無機バリア膜の接着性が増大することを特徴とする請求項 1 記載の方法。

【請求項 3】前記暴露工程を、 H_2 、 N_2 、 NH_3 、希ガス、およびそれらの混合物からなる群から選ばれた、非酸化プラズマ雰囲気内で行うことを特徴とする請求項 1 記載の方法。

【請求項 4】前記非酸化プラズマ雰囲気は、 H_2 であることを特徴とする請求項 3 記載の方法。

【請求項 5】前記非酸化プラズマ雰囲気は、 NH_3 であることを特徴とする請求項 3 記載の方法。

【請求項 6】前記暴露工程を、約 1～約 3600 秒の期間、約 20～約 600℃の温度で行うことを特徴とする請求項 1 記載の方法。

【請求項 7】前記暴露工程を、約 5～約 30 秒の期間、約 360～約 400℃の温度で行うことを特徴とする請求項 6 記載の方法。

【請求項 8】前記暴露工程を、約 1 mTorr～約 20 Torr の圧力、約 50～約 10,000 W の電力、および約 1～約 10,000 sccm のガス流量で行うことを特徴とする請求項 1 記載の方法。

【請求項 9】前記暴露工程を、約 3～約 6 mTorr の圧力、約 1500～約 3000 W の電力、および約 10～約 50 sccm のガス流量で、高密度プラズマ化学気相成長法により行うことを特徴とする請求項 1 記載の方法。

【請求項 10】前記暴露工程を、約 2～約 8 Torr の圧力、約 150～約 400 W の電力、約 100～約 200 sccm のガス流量で、プラズマ励起化学気相成長法により行うことを特徴とする請求項 1 記載の方法。

【請求項 11】前記無機バリア膜を、化学気相成長法、低圧化学気相成長法、プラズマ励起化学気相成長法、および高密度プラズマ化学気相成長法からなる群から選ばれた付着処理を用いてその場で形成することを特徴とする請求項 1 記載の方法。

【請求項 12】前記無機バリア膜を、プラズマ励起化学気相成長法または高密度プラズマ化学気相成長法によりその場で形成することを特徴とする請求項 11 記載の方法。

【請求項 13】前記無機バリア膜は、 Si_3N_4 、 SiC 、水素化 Si_3N_4 、および水素化 SiC なる群から選ばれた材料からなることを特徴とする請求項 1 記載の方法。

【請求項 14】前記無機バリア膜は、水素化 Si_3N_4

または水素化 SiC であることを特徴とする請求項 13 記載の方法。

【請求項 15】前記相互接続構造は、 SiO_2 、フッ化 SiO_2 、 Si_3N_4 、ポリイミド、ダイヤモンド、ダイヤモンド状炭素、シリコンポリマー、パラリンポリマー、およびフッ化ダイヤモンド状炭素からなる群から選ばれた誘電体材料を有することを特徴とする請求項 1 記載の方法。

【請求項 16】前記誘電体材料は、 SiO_2 であることを特徴とする請求項 15 記載の方法。

【請求項 17】前記銅の層は、トレンチの内部に形成されることを特徴とする請求項 1 記載の方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】この発明は、相互接続半導体構造に関し、特に、このような相互接続構造の銅線または銅パイアに対する Si_3N_4 のような無機バリア膜の接着性を改良する方法に関する。用語“相互接続構造”は、この明細書の中では広い意味で、銅相互接続メタラジ (metallurgy) を有するあらゆる半導体構造を含むものとして使用される。したがって、この発明は、ダマシン構造 (シングルおよびデュアル)、メモリセル・キャパシタ、および論理、メモリ、入力/出力応用のための他の配線応用における使用に適用できる。

【0002】

【従来の技術】半導体工業においては、アルミニウムおよびアルミニウム合金が、従来の相互接続メタラジとして用いられてきた。アルミニウムをベースとするメタラジは、過去長年にわたり金属の相互接続として使用される選択材料であるが、現在、アルミニウムが、半導体デバイスの回路密度および回路スピードの増大に伴い必要とされる要求に合致するかどうかという問題が存在する。これらの増大する問題のために、他の材料が、アルミニウムをベースとするメタラジに対し可能な代替物として検討されてきた。アルミニウム・メタラジに対し可能な代替物として現在考えられている非常に有利な材料の 1 つが銅である。これは、銅が、アルミニウムに比べて、エレクトロマイグレーション障害に対してさらに低い感受性と、低い抵抗率とを示すためである。

【0003】これらの利点にもかかわらず、銅は、以降の処理工程の際に、周囲の誘電体材料の中へ容易に拡散するという問題を有する。銅の拡散を避けるためには、銅相互接続部は、多くの場合、保護バリア層でキャップされる。キャップする方法の 1 つは、銅相互接続部の側壁および底部に沿った、タンタルまたはチタン、あるいはそれらの合金よりなる導電性バリア層の使用を含んでいる。銅相互接続部の上面をキャップするためには、窒化シリコン (Si_3N_4) のような誘電体材料が典型的に用いられる。

【0004】銅の付着後に低温処理する必要があるため

に、窒化シリコン層は、450℃以下の温度で附着される。したがって、窒化シリコンの附着は、プラズマ励起化学気相成長法(PECVD)または高密度プラズマ化学気相成長法(HDPCVD)を用いて、典型的に行われる。これらの方法では、附着温度は一般的に約200~約500℃である。

【0005】PECVDおよびHDPCVDの窒化シリコンは、半導体デバイス工業において多くの他の応用に用いられてきた。しかし、銅相互接続部に窒化シリコンキャップ(保護膜)を用いる場合、通常のPECVDまたはHDPCVDの窒化シリコンは、信頼性の問題を生じる。特に、通常のPECVDまたはHDPCVD処理を用いて附着された窒化シリコン膜は、一般的に銅表面に対し劣った接着性を示す。例えば、特に、以降の誘電体の附着、メタライゼーション、および化学機械研磨の際に、ある部分の窒化膜は、剥離し、バレーニングされた銅配線の上にブリスト(blisters)を形成する。

【0006】これらの結果は、実際の製造プロセスにおいて、窒化シリコン膜が銅に対して接着しうる程度を示している。銅メタラジの上に附着された後に、一般的に、絶縁層が窒化シリコン膜の上に附着される。しかし、窒化膜の上への絶縁層の附着は、応力を生じ、この応力は、窒化シリコン膜を、銅表面から剥離させる。この剥離は、金属間誘電体のリフト、銅線のリフト、およびキャップされていない銅線からの銅拡散を含むいくつかの破壊的障害メカニズムを生じる。このような結果は、デュアル・ダマシン処理において、一般的に見られる。デュアル・ダマシン処理では、窒化シリコンRIE停止層の剥離が、一般的に、銅の化学機械研磨(CMP)の際に生じる。

【0007】従来技術の銅に対する窒化物の接着性は、銅をシリコンと反応させることによって、銅表面をシリサイド化することを要する。この従来技術の方法は、2つの欠点を有する。すなわち、銅と反応し、銅の中に拡散するシリコンのために銅のシート抵抗を増大すること、および不完全なまたは部分的な銅シリサイドの形成のために銅に対する窒化物の接着性に限界があるということである。

【0008】従来技術の銅相互接続構造についての上述した欠点のために、相互接続半導体構造に存在する銅表面に対する無機バリア膜の接着性を増大する新しい方法を開発する必要性が依然として存在する。

【0009】

【発明が解決しようとする課題】この発明の目的は、相互接続構造の銅表面に対する、附着無機バリア膜の接着性を改良する方法を提供することにある。

【0010】この発明の他の目的は、以降の相互接続処理工程の際に、附着無機バリア膜が、相互接続構造の銅表面から剥離しない方法を提供することにある。

【0011】さらにこの発明の他の目的は、銅配線または銅バリアに対する Si_3N_4 エッチング停止層の接着性を改良する、デュアル・ダマシン処理に用いることのできる方法を提供することにある。

【0012】

【課題を解決するための手段】これらおよび他の目的と利点を、この発明においては、銅相互接続構造上に無機バリア膜を形成する前に、相互接続半導体構造内の銅の層を還元プラズマに暴露する工程を含む方法を用いることにより、達成することができる。特に、相互接続構造の銅表面上の附着無機バリア膜の接着性を改良する、この発明の方法は、(a)少なくとも1つの銅の層を有する相互接続半導体構造を還元プラズマに暴露する工程と、(b)前記プラズマに暴露された銅相互接続構造の上に、無機バリア膜を形成する工程とを含む。

【0013】この発明の方法によれば、暴露工程、すなわち工程(a)は、 H_2 、 N_2 、 NH_3 、 He 、 Ne 、 Ar 、 Kr 、 Xe のような希ガス、およびそれらの混合物からなる群から選ばれた、少なくとも1種の非酸化ガスを含むプラズマ内で行われる。酸化雰囲気は、相互接続構造内に存在する銅を酸化させ、銅界面の窒化物を劣化させるので、酸化雰囲気がこの意図から除外されることと分かる。

【0014】この発明において意図される適切な相互接続構造は、平板キャパシタと、クランウ・キャパシタと、スタック・キャパシタと、他の同様なキャパシタとを有するメモリセル・キャパシタ、シングルおよびデュアル・ダマシン構造、複数のバリアおよび金属線を有する多層配線レベル、および他の同様の相互接続構造を含むが、これらに限られるものではない。

【0015】

【発明の実施の形態】相互接続半導体構造に存在する銅表面上の附着無機バリア膜の接着性を改良する方法であるこの発明を、図1を参照してより詳細に説明する。この発明は、デュアル・ダマシン構造のみを説明するが、銅メタラジを有し、保護バリアまたはエッチング停止層として、例えば SiC または Si_3N_4 のような附着無機バリア膜を用いるすべての相互接続半導体構造に適用できることを強調しておく。

【0016】図1は、この発明の方法を適用できる典型的なデュアル・ダマシン構造を示す。特に、このデュアル・ダマシン構造は、下部相互接続レベル10および上部相互接続レベル12を有する。各レベルは、バリア領域14、および金属線または配線領域16を有する。下部相互接続レベル10は、開口またはトレンチ(銅20で充填されている)を有する誘電体18を有する。下部相互接続レベル10の上部には、上部相互接続レベル12があり、このレベルは、下部相互接続レベルの銅配線につながるトレンチ領域を持つ誘電体22を有している。上部相互接続レベル12のトレンチ領域は、銅20

で充填される。各相互接続レベル間には、RIE停止層、保護バリア膜、またはそれら両方として役立つ無機バリア層24がある。

【0017】図に示されるデュアル・ダマシン構造は、バリア層24を形成する前に、相互接続構造にこの発明の方法（後に、より詳細に説明される）を適用することを除いて、当業者に周知の典型的なダマシン処理工程を用いて作製される。

【0018】誘電体層18、22は、同一または異なる、絶縁性の無機材料または有機材料とすることができる。適切な誘電体は、 SiO_2 、フッ化 SiO_2 、 Si_3N_4 、ポリイミド、ダイヤモンド、ダイヤモンド状炭素、シリコンポリマー、パラリン（paralyne）ポリマー、フッ化ダイヤモンド炭素、および他の同様な誘電体化合物を含むが、これらに限られるものではない。これらの誘電体材料のうち、誘電体層18、22は、 SiO_2 から成ることが好ましい。誘電体層は、ドーピングするあるいはドーピングしないこともできる。ドーピングする場合には、ドーパントを、ホウ素、フッ素、リン、重水素、シリコン、Ge（ゲルマニウム）、または他の同様なドーパントとすることができる。

【0019】バリア層24は、バリアのためのRIE停止層として役立つ、あるいは構造の最外層として存在するときには、保護バリア層として役立つ無機材料である。バリア層24のための適切な材料は、 Si_3N_4 、 SiC 、水素化 Si_3N_4 、および水素化 SiC を含むが、これらに限られるものではない。これらの材料のうち、この発明においては、バリア層として水素添加形態の Si_3N_4 、 SiC を用いることが好ましい。また、選択的なRIE停止層を、金属線16とバリア14との間に挿入することもできる（この実施例は、図面に示されていない）。

【0020】バリア層24は、通常の気相成長方法を用いて形成される。通常の気相成長方法は、化学気相成長法、低圧化学気相成長法、高圧化学気相成長法、高密度プラズマ化学気相成長法、プラズマ励起化学気相成長法、および他の同様の気相成長法を含むが、これらに限られるものではない。これらの付着方法のうち、プラズマ励起化学気相成長法（PECVD）および高密度プラズマ化学気相成長法（HDP-CVD）は、バリア層を付着する好適な方法である。

【0021】図面に示されるデュアル・ダマシン構造、および他に考えられるあらゆる銅相互接続構造は、当業者に周知の方法を用いて作製されることを、もう一度強調しておく。このような方法は周知であり、この発明を理解するためには重大でないため、同じ詳細な議論をここでは行わない。この発明の相互接続構造と従来技術の相互接続構造とを製作することにおける唯一の相違は、無機バリア層24を付着する前に、銅相互接続構造を、以下に定義される条件下で還元プラズマに暴露する

ことである。

【0022】特に、この発明において用いられる還元プラズマは、非酸化の、すなわち酸素原子を含まないプラズマ雰囲気である。この発明において用いられる適切な還元プラズマは、 H_2 、 N_2 、 NH_3 、および希ガスを含むが、これらに限られるものではない。また、 N_2 および H_2 のような、これらの還元プラズマの2種以上の組み合わせも、意図される。これらの還元プラズマのうち、 H_2 および NH_3 は、この発明においては非常に好適である。

【0023】この発明の還元プラズマ暴露工程は、プラズマガスを発生できる通常のプラズマ付着装置で行われる。特に、この発明の暴露工程は、約1〜約3600秒の期間、約20〜約600°Cの温度で行われる。また、3600秒より長い暴露時間も、意図される。さらに好ましくは、この発明の暴露工程は、約5〜約30秒の期間、約360〜約400°Cの温度で行われる。好ましくは、加熱は、還元プラズマの存在下で行われる。

【0024】さらに、この発明の暴露工程は、約1mTorr〜約20Torrの圧力、約50〜約10,000Wの電力、および約1〜約10,000sccmのガス流量で行われる。厳密な条件は、バリア層の形成に用いられる付着処理の種類による。例えば、高密度プラズマ化学気相成長法（HDP-CVD）が使用される場合、この発明の暴露工程は、約3〜約6mTorrの圧力、約1500〜約3000Wの電力、および約10〜約50sccmのガス流量で行われる。一方、プラズマ励起化学気相成長法（PECVD）が用いられるとき、この発明の暴露工程は、約2〜約8Torrの圧力、約150〜約400Wの電力、および約100〜約2000sccmのガス流量で行われる。

【0025】暴露工程直後に、真空状態を中断することなく、無機バリア層が、前述した付着方法のいずれかを用いて銅の上に形成されることに注意されたい。この発明の方法、特に、還元プラズマ暴露工程は、無機バリア層が、今までに従来技術で得られたよりも抵抗を増加させることなく、銅配線または銅バリアに対する改良された接着性を有する銅相互接続構造を与える。したがって、接着性が、この発明の方法を用いて改良されたため、このように形成された銅相互接続構造は、化学機械研磨のような以降の処理工程の際に、従来技術の相互接続構造で通常直面する、あらゆる剥離の問題を示さない。さらに、この発明の方法を用いて製造された相互接続構造は、それらの抵抗増加をほとんど示さない。

【0026】以下の実施例は、この発明の範囲を説明するために与えられる。この実施例は、実施された発明だけを例示するために与えられているので、この発明は、この実施例に限られるものではない。

【0027】

【実施例】この発明の方法を用いて得られる、無機気相

成層バリア層と銅配線との間の改良された接着性を説明するために、一連の実験が、 SiO_2 内にダマシンにより作製された銅線を有する 200 mm の Si ウエハ上で行われた。特に、デュアル・ダマシン構造の銅配線上に Si_3N_4 を付着する前に、表面が、無処理 (CE 1)、酸化プラズマガス雰囲気内での処理 (CE 2)、またはこの発明の方法による還元プラズマ内での処理を含む種々の方法を用いて処理されたことを除いて、デュアル・ダマシン構造を、標準的なダマシン処理条件を用いて準備した。付着前の処理、 Si_3N_4 付着、金属間

付着、およびデュアル・ダマシン銅配線/銅バリア作製の後に、各構造は、剥離について光学的に調べられた。これら実験の結果は、以下の表 1 にまとめられている。表 1 において、実質的にほとんど剥離がないことは“良”と示され、すなわち接着性が改良されており、“不良”は実質的に接着性のないことを示している。また、窒化物の接着性が改良されたことにもとない、銅表面はさらに反射的になったことも観察された。

【0028】

【表 1】

Si_3N_4 付着前の処理	圧力	高出力 (W)	電極	温度 (°C)	付着 Si_3N_4 接着性	CMP 後の Si_3N_4 接着性	4.34 nm の反折率
無処理 (CE 1)	—	—	—	—	不良	不良	0.50
PECVD NH_3	5 Torr	300	1 cm 平行平板	250	良	良に近い	0.58
PECVD NH_3	5 Torr	300	1 cm 平行平板	400	良	良に近い	0.58
PECVD N_2	5 Torr	300	1 cm 平行平板	250	良	不良	測定不能
PECVD $\text{N}_2\text{O} + \text{N}_2$ (1:1) (CE 2)	5 Torr	300	1 cm 平行平板	250	不良	不良	測定不能
HDP CVD $\text{N}_2 + \text{H}_2$	5 mTorr	2000	誘導結合	375	良	良	0.55
HDP CVD H_2	5 mTorr	2000	誘導結合	375	良	良	0.63
HDP CVD N_2	5 mTorr	2000	誘導結合	376	良	良	0.69
HDP CVD NH_3	5 mTorr	2000	誘導結合	375	良	不良	0.53

【0029】前述の結果は、この発明の還元プラズマ暴露工程を用いることにより、銅に対する Si_3N_4 バリア層の改良された接着性を得ることができることを明確に示している。比較例 (CE 1 および CE 2) においては、接着性が劣り、 Si_3N_4 付着膜の剥離が観察された。

【0030】この発明を、この発明の好適な実施例に関して説明したが、形態および詳細における前述および他の変更を、この発明の主旨と範囲から逸脱することなく行うことができることは、当業者には理解されるであろう。

【0031】まとめとして、この発明の構成に関して以下の事項を開示する。

(1) 銅相互接続構造の形成方法において、(a) 銅の層を有する相互接続半導体構造を還元プラズマに暴露する工程と、(b) 前記暴露された銅相互接続構造上に、無機バリア膜を形成する工程と、を含むことを特徴とする方法。

(2) 前記暴露工程を、 H_2 、 N_2 、 NH_3 、希ガス、およびそれらの混合物からなる群から選ばれた、非酸化プラズマ雰囲気内で行うことを特徴とする (1) に記載の方法。

(3) 前記非酸化プラズマ雰囲気は、 H_2 であることを特徴とする (2) に記載の方法。

(4) 前記非酸化プラズマ雰囲気は、 NH_3 であることを特徴とする (2) に記載の方法。

(5) 前記暴露工程を、約 1~約 3600 秒の期間、または 3600 秒より長い期間、約 20~約 600°C の温度で行うことを特徴とする (1) に記載の方法。

(6) 前記暴露工程を、約 5~約 30 秒の期間、約 360~約 400°C の温度で行うことを特徴とする (5) に記載の方法。

(7) 前記暴露工程を、約 1 mTorr~約 20 Torr の圧力、約 50~約 10,000 W の電力、および約 1~約 10,000 sccm のガス流量で行うことを特徴とする (1) に記載の方法。

(8) 前記暴露工程を、約 3~約 6 mTorr の圧力、約 1500~約 3000 W の電力、および約 10~約 50 sccm のガス流量で、高密度プラズマ化学気相成長法により行うことを特徴とする (1) に記載の方法。

(9) 前記暴露工程を、約 2~約 8 Torr の圧力、約 150~約 400 W の電力、約 100~約 2000 sccm のガス流量で、プラズマ励起化学気相成長法により行うことを特徴とする (1) に記載の方法。

(10) 前記銅相互接続構造は、キャパシタ構造、ダマシン構造、または複数のバリアおよび金属線を有する多層配線レベルであることを特徴とする (1) に記載の方法。

(11) 前記銅相互接続構造を、銅線および銅バリアを有する、シングルまたはデュアル・ダマシン構造であることを特徴とする (10) に記載の方法。

(12) 前記無機バリア膜を、化学気相成長法、低圧化学気相成長法、プラズマ励起化学気相成長法、および高密度プラズマ化学気相成長法からなる群から選ばれた付着処理を用いてその場で形成することを特徴とする

(1)に記載の方法。

(13) 前記無機バリア膜を、プラズマ励起化学気相成長法または高密度プラズマ化学気相成長法によりその場で形成することを特徴とする(12)に記載の方法。

(14) 前記無機バリア膜は、 Si_3N_4 、 SiC 、水素化 Si_3N_4 、または水素化 SiC からなることを特徴とする(1)に記載の方法。

(15) 前記無機バリア膜は、水素化 Si_3N_4 または水素化 SiC であることを特徴とする(14)に記載の方法。

(16) 前記相互接続構造は、 SiO_2 、フッ化 SiO_2 、 Si_3N_4 、ポリイミド、ダイヤモンド、ダイヤモンド状炭素、シリコンポリマー、パラリンポリマー、およびフッ化ダイヤモンド状炭素からなる群から選ばれた誘電体材料を有することを特徴とする(1)に記載の

方法。

(17) 前記誘電体材料は、 SiO_2 であることを特徴とする(16)に記載の方法。

(18) 前記銅の層は、トレンチの内部に形成されることを特徴とする(1)に記載の方法。

(19) 前記暴露によって、前記銅相互接続構造上に形成された前記無機バリア膜の接着性が增大することを特徴とする(1)に記載の方法。

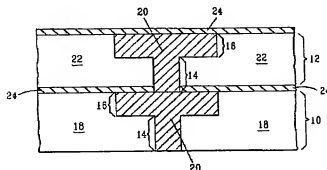
【図面の簡単な説明】

【図1】典型的なデュアル・ダマシ構造の断面図である。

【符号の説明】

- 10 下部相互接続レベル
- 12 上部相互接続レベル
- 14 バイア領域
- 16 金属線または配線領域
- 18、22 誘電体
- 20 銅
- 24 無機バリア層

【図1】



フロントページの続き

- (72)発明者 ボウル・ディー・アグネロ
アメリカ合衆国 12590 ニューヨーク州
ワッピンガーズ フォールズ プレイ
ファーム レーン 17
- (72)発明者 リーナ・ビー・ブックウォルター
アメリカ合衆国 12533 ニューヨーク州
ホープウェル ジャンクション コーチ
ランタン ドライブ 9

- (72)発明者 ジョン・ハメル
アメリカ合衆国 12545 ニューヨーク州
ミルブルック キルバーン ロード
117
- (72)発明者 バーバラ・ルーサー
アメリカ合衆国 10516 ニューヨーク州
コールド スプリング クノールウッド
レーン 1
- (72)発明者 アンソニー・ケイ・スタンパー
アメリカ合衆国 05495 バーモント州
ウィリストン エヴァーグリーン ロード
46